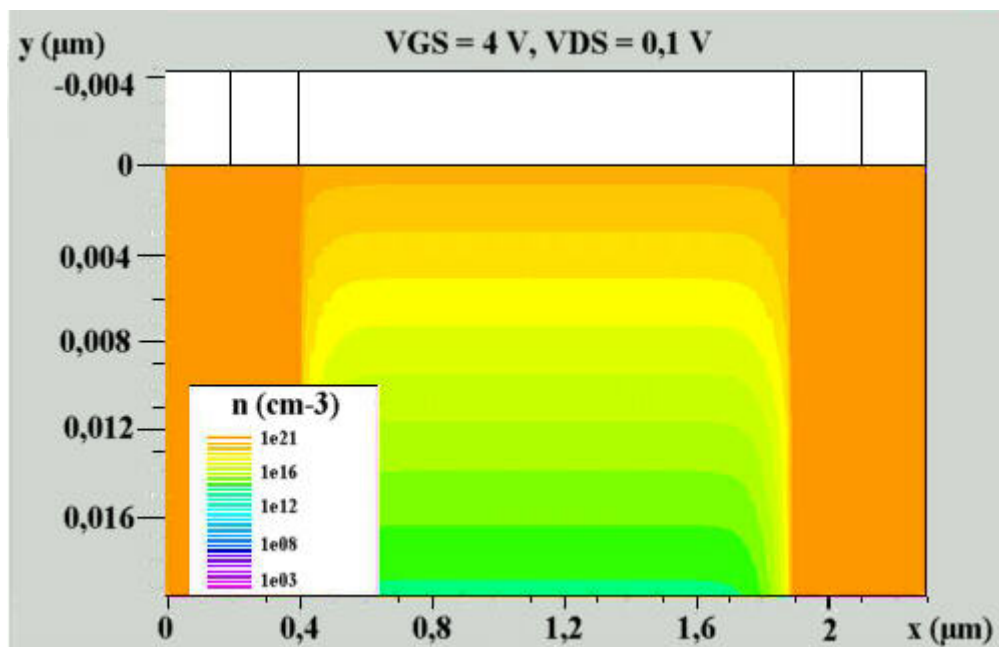
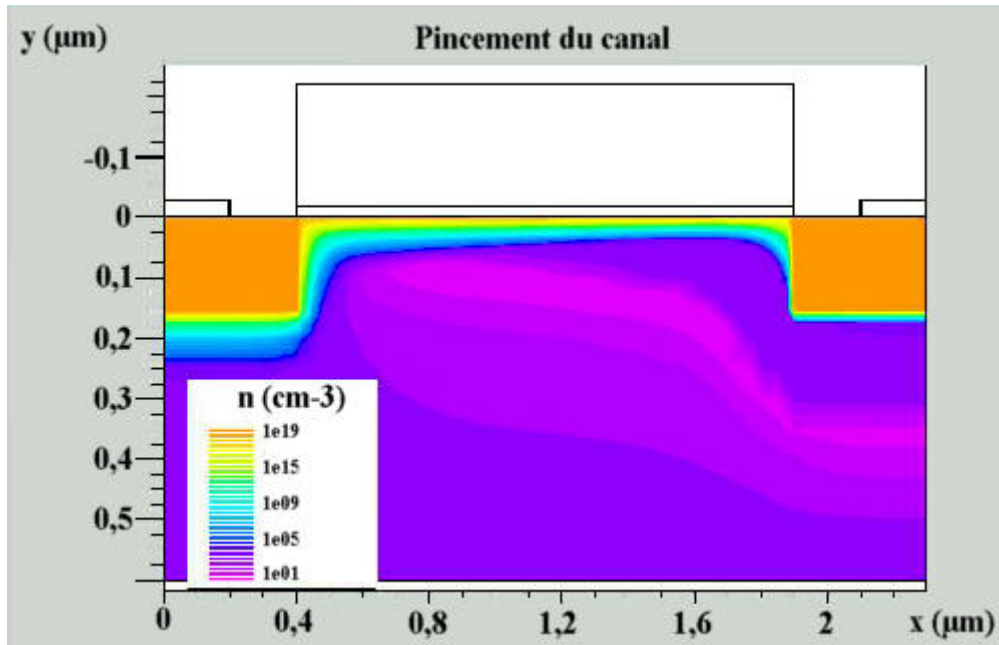
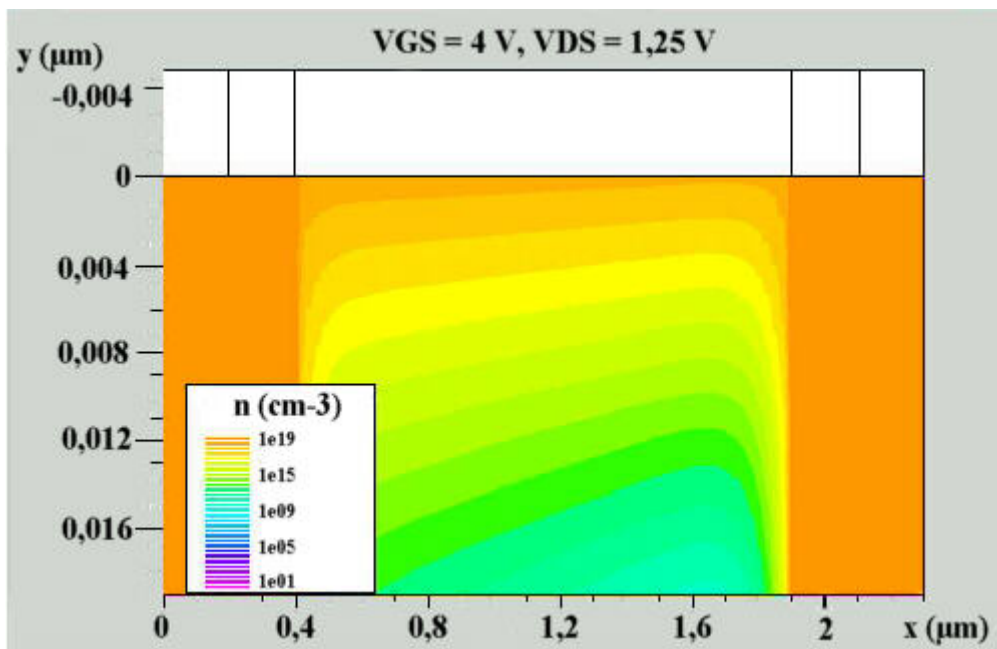


Annexe 2. Pincement du canal.

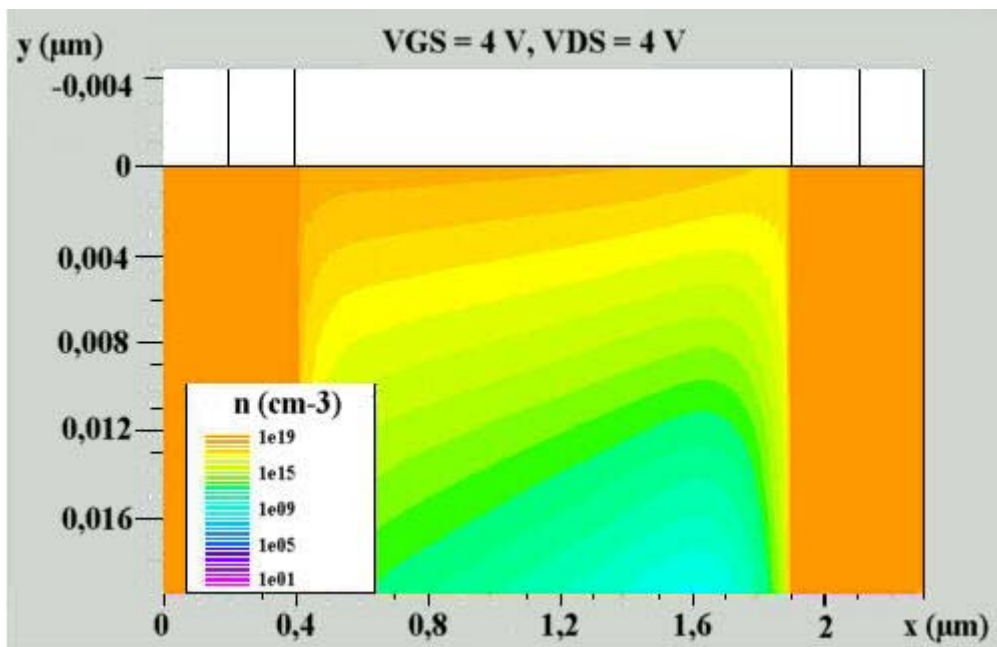
Le pincement du canal quand V_{DS} augmente peut également être illustré par des résultats de simulation.



a) À V_{DS} faible, le canal formé est homogène de la source jusqu'au drain.



b) Quand V_{DS} augmente, la densité d'électrons diminue du côté du drain.



c) À V_{DS} grand, le canal est pincé du côté du drain.